

智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第33號

上訴人 楊秋忠

訴訟代理人 藺超群律師

輔佐人 林明璇

被上訴人 立吉科技有限公司

兼法定代理人陳慧珊

上二人共同

訴訟代理人 吳尚昆律師

葉思慧律師

被上訴人 覆晶光電有限公司

兼法定代理人韓昌洙

上二人共同

訴訟代理人 范國華律師

郭凌豪律師

上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國107年8月24日本院106民專訴字第100號第一審判決提起上訴，本院於108年8月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、按第二審當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第6款定有明文。本件原審於民國（下同）107年4月9日言詞

01 辯論期日整理兩造爭點，並諭知被告如有其他無效抗辯證據
02 應於107 年4 月30日之前提出，嗣被上訴人覆晶光電有限公
03 司（下稱覆晶公司）於107 年6 月4 日言詞辯論期日（當日
04 預定要進行有效性辯論），始當庭提出新的有效性證據即被
05 證2-7，原審以其無正當理由逾時提出證據為由，不予審酌
06 。被上訴人覆晶公司於本院第二審程序仍主張該項證據，並
07 陳稱係因為上訴人在107 年4 月30才提出中華民國第I285968
08 號「具高效率散熱及亮度之晶片」發明專利（下稱系爭專利
09 2）「大面積」是指面積大於電極的導電層的解釋，故被上
10 訴人覆晶公司收受書狀後才尋找相關前案技術，致無法於原
11 審指定之107 年4 月30日前提出等語。本院審酌被上訴人覆
12 晶公司於原審已提出該項證據，且於本院尚未整理爭點之前
13 已再為主張，且該證據涉及系爭專利2 有效性之爭執，為上
14 訴人主張被上訴人等侵害其專利權之前提要件，如不許被上
15 訴人覆晶公司提出，將會有顯失公平之情形，故於108 年5
16 月15日準備程序已諭知就被證2-7 是否可證明系爭專利2 請
17 求項1 不具新穎性應列入爭點（見本院卷二第71頁），並經
18 兩造就該爭點互為攻防完畢，本院自應加以審究。

19 二、按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，
20 於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，
21 或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之
22 終結者，法院得駁回之，民事訴訟法第196 條第1、2 項定
23 有明文。又按未於準備程序主張之事項，除有民事訴訟法第
24 276 條第1 項第1 至4 款之情形，於準備程序後行言詞辯論
25 時，不得主張之，民事訴訟法第463 條準用第276 條第1 項
26 規定甚明。被上訴人覆晶公司於本院第二審程序，經本院協

同兩造整理爭點，並就有效性互為攻防完畢，並宣示準備程序終結後，始於108年7月26日綜合辯論意旨狀，主張被證2-3、被證2-7之組合，足以證明系爭專利2請求項1不具進步性（見該書狀第22-23頁），此一新的證據組合方式，於先前準備程序中均未提出，並經上訴人於108年8月1日言詞辯論期日提出異議，被上訴人覆晶公司於準備程序終結後提出新的證據組合方式，自屬逾時提出攻擊防禦方法且有礙訴訟終結，違反上開民事訴訟法之規定，復未釋明有民事訴訟法第276條第1項第1至4款所列之情形，該逾時提出之攻擊防禦方法，本院不予審酌。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張略以：

一、上訴人為中華民國第I281271號「未經封裝製程即可使用之LED製造方法及結構」發明專利（下稱系爭專利1）、系爭專利2及中華民國第I429103號「覆晶發光二極體晶粒及其晶粒陣列」發明專利（下稱系爭專利3）之專利權人。詎被上訴人覆晶公司所製造之「60-600W LED光源」（下稱系爭產品1）及被上訴人立吉科技有限公司（下稱立吉公司）所組裝、販售之「60-600W LED天井燈、投射燈」（下稱系爭產品2），落入上訴人所有之系爭專利1更正後請求項3、5、6、8、系爭專利2請求項1及系爭專利3更正後請求項1之申請專利範圍，已侵害其所有之專利權，爰依專利法第96條第1、2、3項、第97條，民法第185條第1項前段及公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人等排除侵害及連帶負損害賠償責任。

貳、被上訴人覆晶公司、韓昌洙辯稱：

01 一、系爭專利1：

02 (一)系爭專利1 欠缺產業利用性或有違充分揭露義務而有應撤銷
03 之原因：

04 1.系爭專利1 主張其LED 晶片可未經封裝即能安裝於印刷電
05 路板使用，然封裝之目的旨在防潮濕、抗灰塵及防氧化，
06 並非單純只在放大電極，故在業界，LED 晶片皆須經過封
07 裝製程才能使用。系爭專利1 主張LED 晶片未經封裝即可
08 使用，顯然有違業界公知常識，應不具實施之可能，欠缺
09 產業利用性。退步言之，縱現實上系爭專利1 之技術方案
10 果真可以被實現，惟系爭專利1 之說明書及圖式中並未充
11 分揭露其如何在未有封裝層之設置下，提供抗灰塵、防潮
12 濕及防氧化之功效而使產品可以被正常使用，違反系爭專
13 利1 核准時應適用之專利法第26條第2 項「發明說明應明
14 確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者
15 ，能瞭解其內容，並可據以實施」之規定。

16 (二)系爭專利1 請求項3 、5 、6 、8 均不具新穎性、進步性，
17 應為無效：

18 1.被證1-2 說明書第8 頁第16-19 行揭示：「相關本發明之
19 照明單元係光半導體裸晶安裝倒裝片於光半導體裸晶安裝
20 用印刷電路板上的照明單元，其特徵在於使用上述印刷電
21 路板作為光半導體裸晶安裝用印刷電路板」。被證1-2 雖
22 未揭露晶片電極和印刷電路板上之電路之連結、導通及固
23 定是採用錫膏或導電膠來焊接，但不論是以超音波振動方
24 式或是設置錫膏或導電膠，皆為業界常見連結方式，應為
25 所屬領域具有通常知識者可輕易思及而能簡單置換。

26 2.被證1-3 說明書第7 頁第2-12行揭示：「本案創作發明裸

晶式發光二極體，……不須再經封裝製程（傳統覆晶型LED須再封裝成SMD元件），即可以裸晶之SMD LED型態可直接與其他線路板組合。說明書第10頁第5段第19行至第21行記載「第六圖為本發明裸晶式發光二極體與線路板（PCB）3直接利用迴焊爐加熱方式使裸晶式LED14電極（7、8）直接與PCB線路板電極接點15接合在一起。」，以及說明書第11頁第6行至第8行記載「本案發明摒棄了傳統觀念，LED晶粒需經封裝才能使用，因本發明不須封裝，故製程縮短、良率提高、成本也比較低，尤其採用金屬凸塊接點所以散熱性較佳」。另請求項7揭示：「裸晶式發光二極體的製作方法，其電極金屬凸塊焊接材料為金、錫、銀、銅合金或錫鉛或金錫合金」。

3.被證1-4第1頁1.0 INTRODUCTION第4段揭示：COB（將晶片堆疊在電路板或基板上）具有兩個主要的方式：•將晶片打線的技術：首先將電路晶片設置在印刷電路板上，然後再通過具有金或鋁的導線相互連接的芯片與印刷電路板上的線路；和•覆晶技術：在電路晶片的連接點上設置焊料凸點，並以反向方式將晶片焊接到電路板上，藉此在一個步驟中完成連接和互連。覆晶技術亦可使用導電有機基黏粘合劑（而不是焊料）塗佈在有機印刷板上。

二、請求項2：

（一）系爭專利2之請求項1所述「大面積」用語不明確：

系爭專利2請求項1所述大面積中的「大」為一相對之概念，在其請求項中並未指出比較基礎之前提下，所屬領域具通常知識者，根本無法理解面積多大之導電（導熱）層方屬其所稱之大面積導電（導熱）層，致無法預見其所界定之權利

01 範圍，欠缺明確性，違反系爭專利2 核准時應適用之專利法
02 第26條第3 項規定，有應撤銷之原因。

03 (二)系爭專利2 之請求項1 不具新穎性、不具進步性，應為無效
04 ：

05 1.被證2-2 請求項1 揭示：「兩個電極之一為連接到該n 型
06 層11的一n 電極22，而該兩個電極的另一個為連接到該P
07 型層12的一p 電極20，其中每個電極20、22對於由該放射
08 層所放射的光線具有一正常入射反射率超過80% 」。

09 2.被證2-3 說明書第7 頁第2 行至第12行、第11頁第6-8 行
10 揭示：「本創作…就是直接將LED 晶粒製作成SMD 元件，
11 不須經封裝製程即可使用，…，即覆晶型LED 晶粒變成SM
12 D LED 元件，不須再經封裝製程，即可以裸晶之SMD LED
13 型態可直接與其他路線路板組合」，「本案發明摒棄了傳
14 統觀念，LED 晶粒需經封裝才能使用，因本發明不須封裝
15 ，故製程縮短、良率提高、成本也比較低，尤其採用金屬
16 凸塊接點所以散熱性較佳」。

17 3.被證2-4 說明書第9 頁倒數第2 行至第10頁第2 行揭示：
18 「反射層306 ，其材料可以選用金屬鍍層或非金屬材料組
19 合等。在本實施例中，反射層306 之材料包括具有高反射
20 率之金屬鍍層。」

21 4.被證2-5 說明書第6 頁第3-8 行揭示：「金屬層12及金屬
22 層13分別與透明基板覆晶式發光二極體晶粒的p 極與n 極
23 接觸，而金屬層14及金屬層15則與外部電路相連結。底座
24 基板11除固定發光二極體晶粒16外，尚具有導通電流及協
25 助發光二極體晶粒16散熱的功能。因此，底座基板11採用的
26 材料必須具有高導電率及高導熱率」。

01 5.被證2-7 說明書第10頁第18-22 行揭示：「將第一電極
02 370 、第二電極350 以大面積方式整個覆蓋於第二材料層
03 335 之上表面，且分別由一具有導電及反光功能之材質所
04 製成。其中，第一電極370 與第二材料層335 之間設有一
05 表面隔離層379 ，且第一電極370 可藉由第一延伸電極
06 375 而與第一材料層331 形成一電性連接關係」。

07 6.系爭專利2 之請求項1 之技術特徵均已為上開證據所揭示
08 ，故被證2-2 、被證2-4 、被證2-5 、被證2-6 或被證2
09 -7足以證明系爭專利2 請求項1 不具新穎性。被證2-2 及
10 被證2-3 之組合、被證2-3 及被證2-4 之組合、被證2-3
11 及被證2-5 之組合、被證2-2 、被證2-3 、被證2-4 及被
12 證2-5 之組合、或被證2-6 ，足以證明系爭專利2 請求項
13 1 不具進步性。

14 (三)系爭專利3 請求項1 不具新穎性、不具進步性，應為無效：
15 被證3-2 說明書第29頁第7-9 行揭示連接方式也可透過黏著
16 劑，包含「銀膏」。說明書第28頁第13行揭示，LED 晶片1
17 之各電極係透過導電性膏22（例如銀膏）。故被證3-2 可證
18 明系爭專利3 請求項1 不具新穎性。又被證3-2 說明書第25
19 頁第1-8 行揭示n 側電極6 從絕緣薄膜20中形成的窗孔23露
20 出。該窗孔23相當於請求項1 的裸露面積，對本發明所屬技
21 術領域中通常知識者，可直接且無歧異的改變窗孔23的面積
22 ，並推出請求項1 所述之至少625 平方微米及10000 平方微
23 米，故被證3-2 可證明系爭專利3 請求項1 不具進步性。

24 參、被上訴人立吉公司、陳慧珊辯稱：

25 一、原審判決已逐項比對被證1-2 及系爭專利1 之技術特徵，認
26 系爭專利1 之技術特徵已分別於被證1-2 當中揭示，或其所

01 屬技術領域中具有通常知識者依據被證1-2 所教示之製造方
02 法、參酌系爭專利申請時之通常知識（慣用手段）可簡單改
03 變被證1-2 而完成系爭專利1 之發明，或其所屬之技術領域
04 中習知之慣用技術，故被證1-2 足證明系爭專利1 不具進步
05 性。

06 二、原審判決已認定被證2-2 及被證2-3 （即被證1-3 ）之組合
07 ；被證2-2 、被證2-3 、被證2-4 及被證2-5 之組合，可以
08 證明系爭專利2 請求項1 不具進步性。

09 三、原審判決已認定，被證3-2 可以證明系爭專利3 請求項1 不
10 具新穎性，且可證明系爭專利3 請求項1 不具進步性。

11 四、原審判決認定系爭專利有效性已有疑義，故未論斷系爭產品
12 是否落入系爭專利1 、2 、3 之申請專利範圍，並駁回上訴
13 人之訴，並無違誤，上訴人藉詞上訴，並無理由。

14 肆、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴
15 ，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人不得為販賣之要約
16 、販賣、使用或為上述目的而製造、進口、侵害中華民國
17 I281271 號「未經封裝製程即可使用之LED 製造方法及結構
18 」發明專利、I285968 號「具高效率散熱及亮度之晶片」發
19 明專利、I429103 號「覆晶發光二極體晶粒及其晶粒陣列」
20 發明專利之物品及其他侵害系爭專利權之行為。3.被上訴人
21 立吉公司應將「60-600W LED 天井燈、投射燈」等產品全數
22 回收並銷毀或為其他必要之處置。4.被上訴人等應連帶給付
23 上訴人新臺幣（下同）50萬元及自聲明上訴狀繕本送達翌日
24 起迄清償日止，按年息百分之5 計算之利息。5.第四項請求
25 部分，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。6.一、二審訴訟
26 費用由被上訴人連帶負擔。被上訴人覆晶公司、韓昌洙答辯

01 聲明為：1.上訴駁回。2.上訴費用由上訴人負擔。3.如受不
02 利判決，請准供擔保免為假執行。被上訴人立吉公司、陳慧
03 珊答辯聲明為：1.上訴駁回。2.上訴費用由上訴人負擔。3.
04 如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

05 伍、兩造間之主要爭點（本院卷二第69-71頁）：

06 一、被上訴人覆晶公司抗辯：

07 系爭專利1有效性爭點✓

08 (一)系爭專利1 請求項3 、5 、6 、8 是否欠缺產業利用性？

09 (二)系爭專利1 請求項3 、5 、6 、8 是否違反核准時專利法第
10 26條第2 項之規定？

11 (三)被證1-2 是否足以證明系爭專利1 請求項3 、6 不具新穎性
12 ？

13 (四)被證1-2 、被證1-3 、或被證1-4 ，是否足以證明系爭專利
14 1 請求項3 、5 、6 、8 不具進步性？

15 (五)被證1-2 及被證1-3 之組合，是否足以證明系爭專利1 請求
16 項3 、5 、6 、8 不具進步性？

17 系爭專利2有效性爭點✓

18 (六)系爭專利2 請求項1 是否違反核准時專利法第26條第3 項之
19 規定？

20 (七)被證2-2 、被證2-4 、被證2-5 、被證2-6 或被證2-7 ，是
21 否足以證明系爭專利2 請求項1 不具新穎性？

22 (八)被證2-2 及被證2-3 之組合，被證2-3 及被證2-4 之組合，
23 被證2-3 及被證2-5 之組合，被證2-2 、被證2-3 、被證2
24 -4及被證2-5 之組合，或被證2-6 ，是否足以證明系爭專利
25 2 請求項1 不具進步性？

26 系爭專利3 有效性爭點✓

01 (九)被證3-2 是否足以證明系爭專利3 請求項1 不具新穎性？

02 (十)被證3-2 是否足以證明系爭專利3 請求項1 不具進步性？

03 二、被上訴人立吉公司抗辯：

04 (一)被證1 是否足以證明系爭專利1 請求項3 、6 不具新穎性？

05 (二)被證1 是否足以證明系爭專利1 請求項5 、8 不具進步性？

06 (三)系爭專利2 發明說明及請求項1 是否違反核准時專利法第26
07 條第2 、3 項之規定？

08 陸、得心證之理由：

09 一、判斷系爭專利有效性之依據：

10 (一)系爭專利1 申請日為93年10月29日，核准審定日為96年3 月
11 21日；系爭專利2 申請日為93年12月1 日，核准審定日為96
12 年6 月22日。系爭專利1 、2 是否有應撤銷專利權之情事，
13 應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布，93年7 月
14 1 日施行之專利法（下稱92年專利法）為斷。按發明為其所
15 屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
16 完成時，不得依本法申請取得發明專利，92年專利法第22條
17 第4 項定有明文。

18 (二)系爭專利3 申請日為99年6 月10日，核准審定日為93年1 月
19 20日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用
20 之103 年1 月22日修正公布、103 年3 月24日施行之專利法
21 （下稱103 年專利法）為斷。按發明雖無專利法第22條第1
22 項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依
23 申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，
24 103 年專利法第22條第2 項定有明文。

25 二、系爭專利技術分析：

26 (一)系爭專利1 之技術分析：

01 1.系爭專利1 之技術內容：

02 習知技術之LED 製程，係將晶片（10）先行固定至支架（
03 11）、予以打線（12）後，再以封膠（13）方式進行封裝
04 。或有將晶片（20）先行固定到基板（21）上、予以打線
05 （22）、封膠（23）後，再將其焊設於電路基板（24）上
06 使用。另一種覆晶LED 製程，則是將晶片（30）與覆晶基
07 板（31）採高週波焊接（32）方式，再於晶片（30）上封
08 膠（33）封裝，其後之成品再焊設於電路基板（34）上使
09 用。由於習知技術之製程複雜且封裝後之LED 散熱效果不
10 佳，故系爭專利1 乃提供一種未經封裝製程即可使用之
11 LED 製造方法及結構，其係將LED 晶片直接連結、導通、
12 固定於印刷電路板上，並可利用串並聯之連結方式相互連
13 結複數個LED 晶片，藉此消除習知技術之缺點。

14 2.系爭專利1主要圖式如附圖一所示。

15 3.系爭專利1申請專利範圍分析：

16 系爭專利1 原公告之申請專利範圍共計8 項，嗣上訴人於
17 系爭專利1 之舉發案（N01 ）中提出更正本，經經濟部智
18 慧財產局（下稱智慧局）於107 年10月18日作成「107 年
19 1 月12日之更正事項，准予更正。請求項1 、3 、5 至6
20 、8 舉發成立，應予撤銷。請求項2 、4 、7 舉發駁回」
21 之處分（見本院卷一第245-294 頁）。上訴人主張被侵害
22 者為請求項3 、5 、6 、8 ，其內容如下：

23 3.一種未經封裝製程即可使用之LED 製造方法，尤指一種
24 將未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷
25 電路板之LED 製作方法，其LED 之製造方法為：a ．印
26 刷電路板上製設電路，該印刷電路板不包括半導體封裝

用之基板；b．複數LED 晶片置於印刷電路板上，並P、N 電極對齊印刷電路板上對應之電路；c．直接將P、N 電極連結、導通、固定於印刷電路板；據此完成不須封裝之LED 之製造；其中該連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用傳統錫爐或特製設備焊接。

5. 依據申請專利範圍第3 項所述之未經封裝製程即可使用之LED 製造方法，其中該複數免封裝LED 晶片連結、導通、固定之於印刷電路板，得利用串並聯之連結方式作多片LED 晶片之連結、導通、固定，並藉LED 晶片間得以緊靠，且減少小印刷電路板空間。

6. 一種未經封裝製程即可使用之LED 結構，尤指一種將未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED 裝置，其結構係為：一印刷電路板上預設有電路，該印刷電路板不包括半導體封裝用之基板，電路上乃以連結、導通、固定一個以上之LED 晶片之P、N 電極；其中該連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用傳統錫爐或特製設備焊接。

8. 依據申請專利範圍第6 項所述之未經封裝製程即可使用之LED 結構，其中該複數免封裝LED 晶片連結、導通、固定之於印刷電路板，得利用串並聯之連結方式作多片LED 晶片之連結、導通、固定，並藉LED 晶片間得以緊靠，且減少電路印刷電路板空間。

(二)系爭專利2之技術分析：

1.系爭專利2之技術內容：

習用之晶片製成時，在N 極、P 極提供打線處之電極面積（A）皆較大，明顯減少發光面積，且因散熱路徑長（L

01)，散熱導熱面積 (S) 小，所以導熱不易。系爭專利2
02 乃提供一種LED 晶片，其係在P 極 (20)、N 極 (30) 處
03 分別設有大面積導電材 (40、50)，並得以藉由一般焊接
04 錫膏 (70) 焊接於PCB 線路板 (60) 上，藉由前述之大面
05 積導電材 (40、50) 可增大散熱面積並具有反光面功能。

06 2.系爭專利2主要圖式如附圖二所示。

07 3.系爭專利2申請專利範圍分析：

08 系爭專利2申請專利範圍僅1項，內容如下：

09 一種具高效率散熱及亮度之晶片，其特徵在於：該晶片P
10 、N 電極處各增設一層與其連結之大面積導電 (導熱) 層
11 ；藉由其結構組成，達到減少被蝕刻發光層面積、增加亮
12 度，大面積具高效率散熱及增其反光面效果，無須封裝就
13 具有SMD 及覆晶LED 之功能，並減少封裝成本者。

14 (三)系爭專利3 之技術分析：

15 1.系爭專利3技術內容：

16 習知之覆晶發光二極體封裝製程過於複雜，系爭專利3 乃
17 提出一種覆晶發光二極體晶粒，包括一第一型摻雜半導體
18 層 (301)、一第二型摻雜半導體層 (302)、一第一電
19 極層 (303)、一第二電極層 (304) 及一絕緣層 (305
20)，其外部可用絕緣材料形成防護層 (306)。

21 2.系爭專利3主要圖式如附圖三所示。

22 3.系爭專利3申請專利範圍分析：

23 (1)系爭專利3 申請專利範圍共計10項，其中請求項1 、10
24 為獨立項，其餘均為附屬項，上訴人主張被侵害者為請
25 求項1 。上訴人於本院審理中之108 年2 月20日，於系
26 爭專利3 之舉發案 (N01) 申請更正 (見本院卷一第

439-449 頁），智慧局依法應與舉發案合併審定，目前尚未作出處分，惟智慧局函覆本院擬准予更正，已發函通知舉發人就該更正表示意見（見本院卷二第175 -177 頁），兩造於108 年5 月15日準備程序期日同意以108 年2 月20日更正本內容進行審理（見本院卷二第71頁），更正後之請求項1 內容如下：

1. 一種未經封裝即可使用之覆晶發光二極體晶粒，包括：一第一型摻雜半導體層；一第二型摻雜半導體層，鋪設於該第一型摻雜半導體層之底面；一第一電極層，係鋪設於第一型摻雜半導體層之底面且不接觸該第二型摻雜半導體層，且具有一裸露面積以供直接塗佈一導電接合劑；一第二電極層，係鋪設於第二型摻雜半導體層之底面，且具有一裸露面積以供直接塗佈該導電接合劑；一絕緣層，位於該第一電極層與該第二電極層間，以電性隔離且支撐該第一電極層與該第二電極層；以及一防護層，該防護層由絕緣材料製成，該防護層披覆於該覆晶發光二極體晶粒上除了該覆晶發光二極體晶粒頂面、該第一電極層裸露面、該第二電極層裸露面及該絕緣層底面之外所有的表面；其中該第一電極層裸露面、該第二電極層裸露面及該絕緣層底面系由該覆晶發光二極體晶粒底面向上觀視之方向所言；其中該導電接合劑為銀膠或錫膏；其中當該導電接合劑為銀膠時，每一該裸露面積為至少625 平方微米；其中當該導電接合劑為錫膏時，每一該裸露面積為至少10000 平方微米√。

01 三、系爭產品之技術內容：

02 系爭產品1 為被上訴人覆晶公司製造、販賣之「60-600W LE
03 D 光源」產品；系爭產品2 為被上訴人立吉公司向覆晶光電
04 公司購得系爭產品1 後再加以製造、販賣之「60-600W LED
05 天井燈、投射燈」產品。

06 (一)系爭產品1：

07 1.依被證5 「專利侵權比對研究報告」第6 頁所載，系爭產
08 品2 中之LED 晶片結構（即系爭產品1 ，如附圖四所示）
09 ，其係在一藍寶石基板上設有氮化鎵磊晶層，形成一具有
10 發光層的平面型PN接面發光二極體（平面型LED ）。其於
11 P-GaN 區及N-GaN 區上依序設有第一延伸電極（1st pad
12 ）及第二延伸電極（2nd pad ），且在第二延伸電極上再
13 設有一P 型黏著電極（P- bonding pad）及一N 型黏著電
14 極（N- bonding pad），於GaN 磊晶層上表面、第一延伸
15 電極周邊及第二延伸電極底層之間設有一分佈式布拉格反
16 射件（DBR ），而在第二延伸電極與P 型黏著電極、N 型
17 黏著電極之間設有一鈍化層。經由P 型黏著電極及N 型黏
18 著電極而讓LED 晶片固定於LED 固晶區。

19 2.系爭產品1 晶片構造示意圖如附圖四所示。

20 (二)系爭產品2：

21 1.系爭產品2 經拆解後，其內部具有一電路基板，該電路基
22 板上設有複數個LED 連接線路，當複數個LED 晶片（系爭
23 產品1 ）固定於LED 固晶區，將形成LED 陣列，而電路基
24 板上設有依黃色封裝層，封裝層不僅可包覆LED 晶片及部
25 分電路基板，也可以在封裝層內設有螢光粉等光色轉換物
26 質。

01 2.系爭產品2照片如附圖五所示。

02 四、專利有效性證據分析：

03 (一)系爭專利1 之有效性證據：

04 1.被證1：

05 被證1 為2003年10月1 日公開之我國第556028號「發光二
06 極體背光模組」專利案（見原審卷一第153-160 頁），其
07 公告日早於系爭專利1 申請日（2004年10月29日），可為
08 系爭專利1 之相關先前技術。

09 (1)被證1技術內容：

10 習知之背光模組由於將發光源設置於導光板的側邊，因
11 此在使用時容易因光源入射角度不良，而造成背光模組
12 整體亮度不均勻的現象。是以，被證1 揭露一種發光二
13 極體背光模組，包括：一導光板，具有一入光面以及一
14 出光面，該出光面平行該入光面，且上述入光面具有複
15 數個凹陷部，上述出光面設置一導光圖樣；以及複數個
16 發光二極體鑲嵌於上述導光板之上述等凹陷部內。藉由
17 在導光板設置凹陷部，並將發光二極體鑲嵌於凹陷部內
18 ，以幫助光線擴散於導光板及增加亮度。

19 (2)被證1 主要圖示如附圖六所示。

20 2.被證1-2：

21 被證1-2為2004年9 月16日公開之我國第000000000 號「
22 光半導體裸晶、印刷電路板、照明單元及照明裝置」專利
23 案（見原審卷二第40-64 頁），其公開日早於系爭專利1
24 申請日（2004年10月29日），可為系爭專利1 之相關先前
25 技術。

26 (1)被證1-2技術內容：

01 以覆晶方式將LED 裸晶接合於印刷電路板上時，為提高
02 接合強度而將超音波能量設得更強，但可能因振動使得
03 LED 裸晶旋轉而造成短路。因此，被證1-2 乃藉由調整
04 印刷電路板上之配線圖案形狀，使得裸晶縱使旋轉仍不
05 致於造成短路。

06 (2)被證1-2 主要圖示如附圖七所示。

07 3.被證1-3：

08 被證1-3 為2004年6 月21日公告之我國第595015號「裸晶
09 式發光二極體」專利案（見原審卷二第65-74 頁），其公
10 告日早於系爭專利1 申請日（2004年10月29日），可為系
11 爭專利1 之相關先前技術。

12 (1)被證1-3技術內容：

13 被證1-3 係將發光二極體（LED）晶粒直接製作成表面
14 黏著型（SMD）之結構，不須再經封裝製程即可使用，
15 被證1-3 第6 圖揭露將裸晶式發光二極體（14）之電極
16 （7、8）利用迴焊爐加熱方式直接與PCB 線路板（3
17 ）之電極接點（15）相互接合。

18 (2)被證1-3主要圖示如附圖八所示。

19 4.被證1-4：

20 被證1-4 為國際電子工業聯接協會（IPC）於1990年11月
21 公開之「晶片直接封裝（Chip-on-Board）技術實現指南
22」（見原審卷二第75-76 頁），其公開日早於系爭專利1
23 申請日（2004年10月29日），可為系爭專利1 之相關先前
24 技術。其技術內容描述晶片直接封裝涉及兩大技術部分：
25 其一是積體電路晶粒先接合於印刷電路板上後，再藉由打
26 線接合方式進行連接之晶片及打線技術。其二是先在積體

01 電路晶粒上鍍有銲錫凸塊後再以覆晶方式接合於電路板上
02 之覆晶技術。

03 (二)系爭專利2之有效性證據：

04 1.被證2-2：

05 被證2-2為2003年9月21日公告之我國第554549號「鋁
06 鎵銦氮覆晶發光二極體之高反射性歐姆接點」專利案（見
07 原審卷二第97-129頁），其公告日早於系爭專利2申請日
08 （2004年12月1日），可為系爭專利2之相關先前技術。

09 (1)被證2-2技術內容：

10 被證2-2 主要揭露一種具有高反射性歐姆接點的反向Ⅲ
11 族氮化物發光裝置（LED），其包含有為不透明且高反
12 射性的N型及P型電極，並提供良好的電流散佈。每個
13 N型及P型電極於該LED活性區域的尖峰放射波長下每
14 次通過係吸收小於25%的入射光線。

15 (2)被證2-2主要圖示如附圖九所示。

16 2.被證2-3：被證2-3（見原審卷二第130-139頁）同被證
17 1-3，不另贅述。

18 3.被證2-4：

19 被證2-4為2001年11月21日公告之我國第465123號「高功
20 率白色發光二極體」專利案（見原審卷二第140-156頁）
21 ，其公告日早於系爭專利2申請日（2004年12月1日），
22 可為系爭專利2之相關先前技術。

23 (1)被證2-4技術內容：

24 被證2-4 揭露一種高功率白色發光二極體，具有發光二
25 極體晶粒（300）、透明基板（302）、透明歐姆電極
26 （304）、反射層（306）、接觸電極（308a、308b）

，以及覆有導電跡線（314）之散熱承座（310）等。
晶粒（300）表面還覆有螢光膠體（320），用以吸收
發光二極體晶粒（300）產生之部份光線，並發出互補
色之光線，使觀察者所見為白色光。

(2)被證2-4 主要圖示如附圖十所示。

4.被證2-5：

被證2-5為2002年10月11日公告之我國第506145號「具
有透明基板覆晶式發光二極體晶粒的高亮度發光二極體」
專利案（見原審卷二第157-166頁），其公告日早於系爭
專利2 申請日（2004年12月1日），可為系爭專利2 之相
關先前技術。

(1)被證2-5技術內容：

被證2-5 揭露一種高亮度發光二極體，包括：一底座基
板（11）、一具有透明基板的覆晶式發光二極體晶粒（
16）以及一覆蓋基板（17）。該覆蓋基板（17）中央區
域具有一孔，其係以傾斜側壁圍成。該覆晶式發光二極
體晶粒（16）容置於該中央區域的孔中。該底座基板（
11）以一中置絕緣區域（19）分隔為兩部分，其係分別
與該發光二極體晶粒（16）的兩電極連結。

(2)被證2-5 主要圖示如附圖十一所示。

5.被證2-6：

被證2-6為2004年4月27日公告之美國第0000000號「
在導體結構上製造對齊電極之方法」專利案（見原審卷二
第167-173頁），其公告日早於系爭專利2 申請日（2004
年12月1日），可為系爭專利2 之相關先前技術。

(1)被證2-6技術內容：

01 被證2-6 揭露一種用於製造發光二極體透明電極的方法
02 其係在半導體結構的頂面上沉積金屬，並在金屬上形
03 成遮罩，以定義出第一電極之第一區域。該遮罩具有一
04 開口，使得第一區域為遮罩所覆蓋且一第二區域對準該
05 開口。接著移除第二區域中對準該開口之金屬層，以顯
06 露出該第二區域中半導體結構之頂面。藉此在第一區域
07 中形成第一電極，並在第二區域中形成較低的第二電極
08 。

09 (2)被證2-6 主要圖示如附圖十二所示。

10 6.被證2-7：

11 被證2-7 為2004年8 月21日公告之我國第I220578 號「可
12 提高發光作用區域之發光元件」專利案（原審卷四第286
13 -304頁），其公告日早於系爭專利2 申請日（2004年12月
14 1 日），可為系爭專利2 之相關先前技術。

15 (1)被證2-7技術內容：

16 習知之發光二極體兩個電極不在同一水平位置，導致製
17 作上之困難度，被證2-7 所揭露之發光二極體在磊晶層
18 （33）中設有延伸凹槽，並在延伸凹槽內設有一第一延
19 伸電極（375 ），第一延伸電極（375 ）可與第一電極
20 （370 ）電性連接，使第一電極（370 ）與第二電極（
21 350 ）具有相同之水平位置，以利後續製程之進行。

22 (2)被證2-7 主要圖示如附圖十三所示。

23 (三)系爭專利3之有效性證據：

24 1.被證3-2：

25 被證3-2 為2003年7 月11日公告之我國第541724號「使用
26 發光二極體晶片之發光裝置」專利案（見原審卷二第200

-226頁），其公告日早於系爭專利3 申請日（2010年6 月10日），可為系爭專利3 之相關先前技術。

(1)被證3-2技術內容：

被證3-2 揭露一種發光裝置，其係使用以面朝下狀態安裝在安裝基板（8）中的LED 晶片，包含形成於透光性基板（2）上的N 型半導體層（3）、形成於此n 型半導體層（3）之上的P 型半導體層（5）、設置於此等半導體層形成面上並各別連接的電極（6、7）。各電極（6、7）係配置形成為平面狀，俾使LED 晶片（1）之發光面整體約略均勻地點亮，至少其中一電極係構成為亦具有作為光反射部之功能，各電極具有一供電部（15、16），而且，靠近透光性基板（2）之一側之半導體層上所設置的電極係隨著從供電部遠離而縮小寬度。

(2)被證3-2如附圖十四所示。

五、被證1-2 是否足以證明系爭專利1 請求項3、5、6、8 不具進步性？

(一)請求項3：

1.比對系爭專利1 請求項3 與被證1-2 之技術內容：查被證1-2 說明書第5 頁 先前技術V 記載「例如於照明裝置之領域中，現正檢討以倒裝面方式藉著超音波接合而將單面配置著p 電極與n 電極之數百 μm 角大小之單面電極型的LED 裸晶（以下簡稱「LED 晶片」）以多數個且高密度地安裝於印刷電路板上（以下簡稱『電路板』）上，並作為照明裝置使用的技術…」，另說明書第8 頁第5 段記載「…本發明之照明單元係光半導體裸晶安裝倒裝片於光半導

體裸晶安裝用印刷電路板上的照明單元，其特徵在於使用上述印刷電路板作為光半導體裸晶安裝用印刷電路板」、第13頁第4、5段記載「LED晶片14…，以倒裝片方式安裝，以安裝的狀態，LED晶片14之p電極145與配線圖案81之一側端部分82連接，n電極146與配線圖案85之一側端部分86電性地連接…」（參見被證1-2第1至3圖）、「在LED晶片14之安裝上，如以習知技術段落說明的情形，…，以將…LED晶片14押壓於配線板2的狀態，施加預定時間的超音波振動而接合於配線板2…」，由被證1-2上開所載內容，可知其揭示之LED製造方法，係將未封裝之LED晶片（即光半導體裸晶或LED晶片（14））以超音波方式直接安裝於印刷電路板（2）上，且LED晶片（14）之P電極（145）對齊印刷電路板（2）之配線（81），N電極（146）則對齊印刷電路板（2）之配線（85），即對應揭露系爭專利1請求項3之「一種未經封裝製程即可使用之LED製造方法，尤指一種將未封裝LED晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED製作方法，其LED之製造方法為：a．印刷電路板上製設電路，該印刷電路板不包括半導體封裝用之基板；b．複數LED晶片置於印刷電路板上，並P、N電極對齊印刷電路板上對應之電路；c．直接將P、N電極連結、導通、固定於印刷電路板；據此完成不須封裝之LED之製造」技術特徵。

2.承上，被證1-2與系爭專利1請求項3之差異僅在於：被證1-2係以「超音波接合」方式來將LED晶片之P、N電極連結、導通、固定於印刷電路板，而系爭專利1請求項3則界定「連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用

傳統錫爐或特製設備焊接」。惟以錫膏、導電膠，或以傳統錫爐，或特製設備進行焊接，僅係發光二極體技術領域所採用之慣用接合方式，此有被上訴人於原審階段提出之被證15資料可稽。包含我國第557590號專利說明書第10頁載明發光元件（即LED）以錫膏等物質連接於電路板，我國第331042號專利說明書第6、10頁載明LED晶粒以錫膏、銀膠等導電膠接合於基座上，我國第000000000號專利說明書第115頁載明發光二極體係搭載於印有焊錫膏之電路基板，通過紅外線加熱爐使錫膏熔融固著，我國第476452號專利「創作說明」第4頁載明置有發光二極體之反射罩係以導電膠或錫膏連接於印刷電路板上、國際電子工業連接協會於1990年出版之「晶粒直接封裝技術實施指南」（IPC-SM-784 Guidelines for chip-on-board technology implementation）第1頁載明覆晶連接技術可利用導電膠將晶粒連接於印刷電路板，多層電路板術語詳解辭典（90年12月出版）關於「焊錫膏」一詞說明其係表面組裝方式中不可缺少的焊錫，使用網版、以印刷方式塗佈及供給在印刷電路板的焊墊部，以重熔法進行錫焊，及西元1997年1月15日出版（出版日見原審卷五第86頁）之「97年電路板採購及術語手冊」關於「錫膏」一詞說明其可採印刷方式塗於板面的某些定點，並可進一步在高溫中熔融成為錒錫實體，而完成焊接的作業）√（見原審卷五第7-47頁）。再者，上訴人主張系爭產品之LED晶片與印刷電路板之連接方式落入系爭專利1之文義或均等範圍（見上訴人於原審107年5月31日民事準備書狀（三）第5頁），亦自陳「按具系爭專利領域之通常知識者，皆可輕易知

01 悉錫膏屬本領域常用之焊接材料」等語（見原審卷四第24
02 7 頁），足見以錫膏作為LED 與印刷電路板間之連接材料
03 乃該領域中之通常知識。故發明所屬技術領域中具通常知
04 識者，依據被證1-2 所揭示之LED 製造方法，參酌系爭專
05 利申請時之通常知識，當知可選擇以超音波或以錫膏等材
06 料來結合LED 晶片與印刷電路板，並可獲得預期之接合結
07 果，是以系爭專利1 請求項3 之發明，乃該通常知識者簡
08 單改變被證1-2 中關於LED 晶片與印刷電路板間之結合方
09 式所得以輕易完成者，故被證1-2 足以證明系爭專利1 請
10 求項3 不具進步性。

11 3.上訴人雖辯稱，被證1-2 揭露之配線板係覆晶接合時所採
12 用的轉接板，並非系爭專利1 所述之印刷電路板，此由被
13 證1-2 說明書第28頁提及配線板可使用矽基板即知云云。
14 惟查，被證1-2 說明書第5 頁第 先前技術V 明確記載「
15 …LED 裸晶以多數個且高密度地安裝於『印刷電路板』上
16 …」，第8 頁第4 段記載「…前述絕緣板係包含無機質填
17 充物與機脂組成物之複合塑料板。藉此，能廉價地製造『
18 印刷電路板』，易達到多層化等的加工」，且由第12頁第
19 8 至11行記載「配線板2 係加入無機質填充物之熱硬化性
20 樹脂所構成之絕緣板5 、6 （參照第3 圖）之表面形成由
21 金屬所構成之配線圖案8 、7 所構成之基板3 、4 積層多
22 數層（本例為2 層）的構成…」，可知被證1-2 第3 圖中
23 連接LED 晶片（14）之配線板（2 ）即為印刷電路板。至
24 於被證1-2 說明書第28頁第12至13行記載「上述將配線板
25 作為樹脂製之基板，惟不限於此情形，例如亦可使用矽基
26 板等」內容，僅是指出配線板除了可以用樹脂構成外，尚

01 可採用其他材料（例如矽），縱令矽基板並非一般所認知的印刷電路板，但仍無礙於被證1-2 其他部分確已揭露配線板（採用樹脂為材料）為印刷電路板之事實。

04 4.上訴人又辯稱，被證1-2 之目的係解決當LED 晶片於加強
05 超音波能量時，LED 晶片會旋轉導致短路的問題，因而如
06 將被證1-2 之設計改以錫膏或導電膠連接，則更易在加工
07 過程中飄移或產生立碑效應等現象，故所屬技術領域中具有通常知識者無法依被證1-2 而輕易完成系爭專利1 請求
08 項3 之發明云云。惟查，被證1-2 已揭露藉由調整接觸電
09 極之形狀，使得提高超音波接合能量時，縱使LED 晶片旋
10 轉仍不會發生短路（被證1-2 說明書第7 至9 頁），甚而
11 被證1-2 說明書第28頁末段載明「…不限於超音波接合來
12 接合的情形，可應用於使用接合時LED 晶片旋轉之接合方
13 法中的配線板、LED 晶片…」，亦即如採用其他接合方式
14 （例如錫膏或導電膠）而亦有晶片旋轉問題時，所屬技術
15 領域中具有通常知識者當能參考被證1-2 所教示之技術手
16 段解決之。況且系爭專利1 請求項3 係界定將LED 晶片之
17 P、N 電極以錫膏或導電膠連接於印刷電路板，並未具體
18 限定任何解決飄移或立碑現象之技術手段，如謂被證1 -2
19 改採錫膏或導電膠連接時可能產生前述問題，則系爭專利
20 1 請求項3 之發明亦無法排除具有相同問題的可能性，自
21 難以此作為系爭專利1 請求項3 相較於引證1- 2具有進步
22 性之論據。

24 (二)請求項5：

25 系爭專利1 請求項5 係依附於請求項3，並界定「其中該複
26 數免封裝LED 晶片連結、導通、固定之於印刷電路板，得利

用串並聯之連結方式作多片LED 晶片之連結、導通、固定，並藉LED 晶片間得以緊靠，且減少小印刷電路板空間」之附屬技術特徵。查被證1- 2第1 圖及說明書第12頁第14至16行揭示「此等配線圖案7、8 主要係以將各行之第奇數列之LED 晶片與第偶數列之LED 晶片之各個晶片串聯地連接之接縫而形成者」，即揭露以串聯方式連結多個LED 晶片而對應於前述系爭專利1 請求項5 之附屬技術特徵，又被證1-2 足以證明系爭專利1 請求項3 不具進步性之理由，已如前述，是以被證1-2 足以證明系爭專利1 請求項5 不具進步性。

(三)請求項6：

系爭專利1 請求項6 係獨立項，其請求內容即為請求項1 之製造方法所得之LED 結構，如前述被證1-2 與系爭專利1 請求項1 之比對，被證1-2 第3 圖揭露LED 晶片(14)之P、N 電極(145、146)無需透過封裝基板直接連接於配線板(2)之配線(81、85)上，對應於系爭專利1 請求項6 之「一種未經封裝製程即可使用之LED 結構，尤指一種將未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED 裝置，其結構係為：一印刷電路板上預設有電路，該印刷電路板不包括半導體封裝用之基板，電路上乃以連結、導通、固定一個以上之LED 晶片之P、N 電極」技術特徵。雖被證1-2 未揭露系爭專利1 請求項6 之「其中該連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用傳統錫爐或特製設備焊接」技術特徵，惟以錫膏或導電膠作為LED 與印刷電路板間之連接材料乃該領域中之通常知識，業如前述，則系爭專利1 請求項6 之發明，乃所屬技術領域中具通常知識者將被證1-2所揭示之LED 結構，依申請時之通常知識，改以錫膏或導

電膠作為其與印刷電路板間之接合材料所能輕易完成者，故被證1-2 足以證明系爭專利1 請求項6 不具進步性。

(七)請求項8：

系爭專利1 請求項8 係請求項6 之附屬項，其附屬技術特徵同請求項5 之附屬技術特徵，業已為被證1-2 第1 圖及說明書第12頁第14至16行所揭露，且被證1-2 足以證明系爭專利1 請求項6 不具進步性，已如前述，故被證1-2 足以證明系爭專利1 請求項8 不具進步性。

六、被證1-3 是否足以證明系爭專利1 請求項3 、5 、6 、8 不具進步性？

(一)請求項3：

1.比對系爭專利1 請求項3 與被證1-3 之技術內容：查被證1-3 說明書第7 頁第2 至11行記載「本案創作發明裸晶式發光二極體，就是直接將LED 晶粒製作形成SMD 元件，不須經封裝製程即可使用，此創作乃是將大功率晶粒（power chip）結合覆晶接點（Flip chip），…，即覆晶型LED 晶粒變成SMD LED 元件，不須再經封裝製程（傳統覆晶型LED 須再封裝成SMD 元件），即可以裸晶之SMD LED 型態可直接與其他線路板組合」，被證1-3 第6 圖及說明書第10頁倒數第2 段另記載「裸晶式發光二極體與線路板（PCB）3 直接利用迴焊爐加熱方式使裸晶式LED14 電極（7、8）直接與PCB 線路板電極接點15接和在一起」，可知被證1-3 之LED 製造方法係就未經封裝之裸晶LED，將其P、N 電極（8、7）連接於印刷電路板（即PCB 線路板）之電極接點（15），業已揭露系爭專利1 請求項3 之「一種未經封裝製程即可使用之LED 製造方法，

尤指一種將未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED 製作方法，其LED 之製造方法為：a · 印刷電路板上製設電路，該印刷電路板不包括半導體封裝用之基板；b · 複數LED 晶片置於印刷電路板上，並P、N 電極對齊印刷電路板上對應之電路；c · 直接將P、N 電極連結、導通、固定於印刷電路板；據此完成不須封裝之LED 之製造」技術特徵。又前述被證1-3 揭露以「迴焊爐加熱方式」使LED (14) 連接於PCB 線路板，而所謂迴焊爐 (reflow oven) 係迴流焊接用之爐具，即隱含其係以錫膏方式來焊接LED 與PCB 線路板，且被證1-3 請求項7 另揭露電極金屬凸塊焊接材料為金、錫、銀、銅合金或錫鉛或金錫合金，對應揭露系爭專利1 請求項3 之「其中該連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用傳統錫爐或特製設備焊接」技術特徵。是既系爭專利1 請求項3 之全部技術特徵已為被證1-3 所揭露，已如前述，則所屬技術領域中具有通常知識者依被證1-3 之內容，當可輕易完成系爭專利1 請求項3 之發明，故被證1-3 足以證明系爭專利1 請求項3 不具進步性。

2. 上訴人雖抗辯，被證1-3 所述不須封裝，係不須經過「樹脂封裝」即可直接與其他線路板接合，但系爭專利1 所述之未經封裝，係不須經過「一階封裝」，即系爭專利1 乃無須透過封裝基板直接連接於印刷電路板，故被證1-3 未揭露系爭專利1 之「未經封裝」、「未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED 製作方法」技術特徵云云。惟查，被證1-3 第6 圖及說明書內容業已揭露將「裸晶」LED (14) 連接於PCB 線路板 (3) 上，

且LED 晶片（14）與PCB 線路板（3）間並無任何轉接板或封裝基板，是以被證1-3 之LED 製造方法或結構，在裸晶LED 晶片（14）與印刷電路板（3）接合前，既不需樹脂封裝也不需一階封裝，符合系爭專利1 之「未經封裝」、「未封裝LED 晶片、無需透過封裝基板直接連接於印刷電路板之LED 製作方法」技術特徵。

3.上訴人復抗辯，依據被證1-3 請求項6、7 內容可知被證1-3 第6 圖中之P、N 電極（8、7）為金屬凸塊電極，材料成本較高，而系爭專利1 係使用一般金屬電極（非凸塊），故被證1-3 與系爭專利1 之「該連結、導通、固定得採錫膏或導電膠，直接用傳統錫爐或特製設備焊接」連結方式完全不同云云。惟查，系爭專利1 請求項3 並未具體界定LED 之P、N 電極材料，更未排除電極採用金屬凸塊之可能性，況且LED 之整體材料成本並非僅取決電極材料，而與LED 磊晶層材料、製程良率等因素均相關，自難據此認定系爭專利1 相較於被證1-3 具有材料成本之優勢。又縱使被證1-3 採用金屬凸塊來連接LED 與印刷電路板，與系爭專利1 請求項3 之錫膏或導電膠尚有差異，然如前述，以錫膏作為LED 與印刷電路板間之連接材料乃所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識（見被證1-2 與系爭專利1 之比對），上訴人亦自承錫膏係該領域中常用之焊接材料，則前述之技術特徵差異僅是通常知識者依製程需求在已知的焊接材料中之選擇而已，尚難認系爭專利1 請求項3 相較於被證1-3 具進步性，上訴人上開主張，不足採信。

(二)請求項5：

系爭專利1 請求項5 係依附於請求項3 ，並界定利用串並聯之連結方式作多片LED 晶片間連結之附屬技術特徵。查被證1-3 雖未揭露前述附屬技術特徵，惟以串聯或並聯方式來連接多個元件僅是電子電路中慣用之手段，又被證1-3 足以證明系爭專利1 請求項3 不具進步性之理由，已如前述；系爭專利1 請求項5 之發明僅為所屬技術領域中具有通常知識者將被證1-3 中之LED 以串聯或並聯方式連接多個而能輕易完成者，故被證1-3 足以證明系爭專利1 請求項5 不具進步性。

(三)請求項6：

系爭專利1 請求項6 係獨立項，其請求內容即為請求項1 之製造方法所得之LED 結構，如前述被證1-3 與系爭專利1 請求項1 之比對，被證1-3 第6 圖揭露LED 晶片（14）之P、N 電極（8、7）無需透過封裝基板直接連接於PCB 線路板（3）上；被證1-3 另揭露以迴焊爐加熱方式將LED（14）與PCB 線路板（3）相接合，即隱含利用錫膏之技術特徵，況且以錫膏或導電膠作為LED 與印刷電路板間之連接材料乃該領域中之通常知識，故系爭專利1 請求項6 之發明乃所屬技術領域中具通常知識者將被證1-3 所揭示之LED 結構，依申請時之通常知識，改以錫膏或導電膠作為其與印刷電路板間之接合材料所能輕易完成者，故被證1-3 足以證明系爭專利1 請求項6 不具進步性。

(四)請求項8：

系爭專利1 請求項8 係請求項6 之附屬項，其附屬技術特徵同請求項5 之附屬技術特徵，被證1-3 足以證明系爭專利1 請求項5、6 不具進步性之理由，已如前述，故被證1-3 足

01 以證明系爭專利1 請求項8 不具進步性。

02 七、被證1-2 及被證1-3 之組合是否足以證明系爭專利1 請求項
03 3 、5 、6 、8 不具進步性？

04 被證1-2 或被證1-3 均足以證明系爭專利1 請求項3 、5 、
05 6 、8 不具進步性，已如前述，故被證1-2 及被證1-3 之組
06 合亦足以證明系爭專利1 請求項3 、5 、6 、8 不具進步性

07 八、被證2-7 是否足以證明系爭專利2 請求項1 不具新穎性？

08 (一)比對系爭專利2 請求項1 與被證2-7 之技術內容：查被證2
09 -7第6 圖揭露一種發光元件(50)，具有第一電極(370)
10 及第二電極(350)，且第一電極(370)連接有第一延伸
11 電極(375)。是以，被證2-7 之第一電極(370)、第二
12 電極(350)即對應揭露系爭專利2 請求項1 之N 極、P 極
13 ，但被證2-7 並未揭露系爭專利2 請求項1 之大面積導電(
14 導熱)層，故被證2-7 不足以證明系爭專利2 請求項1 不具
15 新穎性。

16 (二)被上訴人雖主張，被證2-7 第6 圖之歐姆接觸層(355)、
17 第一延伸電極(375)係對應揭露系爭專利2 請求項1 之P
18 極、N 極，進而被證2-7 之第二電極(350)、第一電極(
19 370)即對應揭露系爭專利2 請求項1 之大面積導電(導熱
20)層云云。惟依被證2-7 說明書第11頁第2 段所載「在第二
21 材料層…尚可設有一透明接觸層(TCL)或歐姆接觸層355
22 ，以利於作用電流可通過第一電極370 垂直延伸之PN界面，
23 且用以產生背光面…」，可知歐姆接觸層係在輔助工作電流
24 均勻分布，與電極之功能、作用並不相同，當不能將之單獨
25 比對為系爭專利2 之電極。再者，被證2-7 之第一延伸電極
26 (375)係由第一電極(370)延伸而來，換言之，第一延

01 伸電極（375）與第一電極（370）實際上係同一金屬層所
02 構成，自不能將第一電極（370）比對為系爭專利2（位於
03 P極或N極上）之大面積導電（導熱）層，是以被證2-7並
04 未揭露系爭專利2請求項1之「大面積導電（導熱）層」技
05 術特徵，被上訴人之主張，不足採信。

06 九、被證2-2及被證2-3（即被證1-3）之組合是否足以證明系
07 爭專利2請求項1不具進步性？

08 (一)比對系爭專利2請求項1與被證2-2之技術內容：查被證2
09 -2圖6a、6b揭露一連接於次黏著基板（50）上之LED晶片，
10 該LED晶片包含P型電極（20）與N型電極（22），且P型
11 、N型電極（20、22）上設有一層導電介面（41），又依被
12 證2-2說明書第21頁末行至22頁第1行記載「該內連線係經
13 由導電介面41、54來附著到該LED及次黏著。當焊料做為內
14 連線時，該導電介面為可濕化金屬」，可知覆蓋於P型、N
15 型電極（20、22）之導電介面（41）係金屬材質，被證2-2
16 圖6a顯示導電介面（41）具有大面積，故前述被證2-2之技
17 術內容已揭示系爭專利2請求項1之「該晶片P、N電極處
18 各增設一層與其連結之大面積導電（導熱）層」之技術特徵
19 。至於系爭專利2請求項1之「藉由其結構組成，達到減少
20 被蝕刻發光層面積、增加亮度，大面積具高效率散熱及增其
21 反光面效果，無須封裝就具有SMD及覆晶LED之功能，並減
22 少封裝成本者」之技術特徵，僅為功能性描述，並未界定除
23 了大面積導電層以外之結構特徵，且被證2-2說明書第20頁
24 第17至22行業已說明圖6a、6b之LED晶片係「…具有光線產
25 生能力的大面積的高功率LED…藉由降低由該p-n接面到該
26 燈具封裝的熱阻抗，而藉由使用高反射性歐姆接點來增加光

線擷取…」，可見被證2-2 所揭露之LED 亦具有增加亮度及增加散熱效率等功效。是以，系爭專利2 請求項1 之技術特徵既為被證2-2 所揭露，則所屬技術領域中具有通常知識者依被證2-2 之內容自可輕易完成系爭專利2 請求項1 之發明，故被證2-2 及被證2-3 之組合足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性。

(二)上訴人雖抗辯，由被證2-2 說明書內容可知，被證2-2 之LED 晶粒所連接之次黏著基板（50）係封裝基板，與系爭專利2 請求項1 無須封裝即可直接連接至PCB 線路板的結構特徵完全不同，且被證2-2 之導電介面（41）的面積小於P 電極（20）及N 電極（22）云云。惟查，系爭專利2 請求項1 僅記載「無須封裝就具有SMD 及覆晶LED 之功能」，並未記載LED 直接連接至PCB 線路板或排除使用封裝基板之結構特徵，亦無任何關於SMD（表面黏著元件）或覆晶之相關結構，自難認定系爭專利2 請求項1 之發明與被證2-2 有何結構上之差異。況且被證2-2 圖6a、6b揭示之LED 晶粒即係以表面黏著方式連結於次黏著基板（50）上；此外，由被證2-3 說明書第7 頁第2 至3 行記載「本案創作發明裸晶式發光二極體，就是直接將LED 晶粒製作形成SMD 元件，不須經封裝製程即可使用…」，及第6 圖揭示裸晶LED（14）以覆晶及表面黏著方式直接連接於PCB 線路板（3），亦可知將LED 以覆晶及表面黏著方式直接連接於PCB 線路板（無需封裝基板）屬系爭專利2 申請前之習知技術，尚難依此認定系爭專利2 請求項1 具進步性。上訴人又主張，被證2-2 並不具備系爭專利2 之「大面積導電層」云云，惟查，系爭專利2 請求項1 僅界定「大面積導電（導熱）層」，但並未界定「大面

積」之具體尺寸或相對尺寸（即相對於何者之面積為大），
上訴人一方面主張「大面積導電（導熱）層」係指導電（導
熱）層之面積需大到足以透過錫膏將晶粒直接連接至印刷電
路板上（108 年7 月16日民事綜合辯論意旨狀第25頁末段）
，另一方面又主張「大面積導電（導熱）層」係指導電（導
熱）層之面積大於電極（108 年7 月16日民事綜合辯論意旨
狀第35頁第11、12行），益見由系爭專利2 請求項1 之「大
面積導電（導熱）層」並非當然解釋為面積大於電極之導電
（導熱）層。縱令將之解釋為面積大於電極之導電（導熱）
層，由被證2-2 圖6a亦明顯可見導電介面（41）之面積大於
N 型電極（22），甚而被證2-2 說明書第21、22頁教示，內
連線（60）係提供LED 移除熱量之路徑，而內連線厚度及面
積則與可濕化金屬（41）（即導電介面）之面積相關，意即
如要提高LED 之散熱效果，當可增加導電介面（41）之面積
，是以導電介面（41）之面積大小乃所屬技術領域中具有通
常知識者依被證2-2 之教示所得改變或調整，故上訴人上開
辯解，不足採信。

十、被證2-3 及被證2-4 之組合是否足以證明系爭專利2 請求項
1 不具進步性？

（一）比對系爭專利2 請求項1 與被證2-4 之技術內容：查被證2
-4第3 圖及說明書第7、8 頁揭露一種高功率白色發光二極
體晶粒（300），其具有接觸電極（308a）與接觸電極（
308b），並於接觸電極（308a）上設有一反射層（306）。
被上訴人雖主張前述被證2-4 所揭露之接觸電極（308a）上
設有反射層（306），即對應系爭專利2 請求項1 之P、N
電極處增有大面積導電（導熱）層之技術特徵。惟查，被證

2-4 僅於接觸電極（308a）上設有反射層，並未在另一接觸電極（308b）上設有反射層，與系爭專利2 請求項1 之「晶片P、N 電極處『各』增設一層與其連結之大面積導電（導熱）層」技術特徵不符。再者，被證2-4 說明書第8 頁第8 至10行記載「…其中透明歐姆電極304、反射層306 與第一接觸電極308a合稱為p 型電極，而第二接觸電極308b則為n 型電極」，可見被證2-4 之反射層（306）實為p 型電極之一部分，自不等同於系爭專利2 設於P、N 電極上之大面積導電（導熱）層，故被證2-4 並未揭露系爭專利2 請求項1 之「大面積導電（導熱）層」技術特徵。

(二)另查，被證2-3 係揭露將發光二極體晶粒直接製作成表面黏著型（SMD）之結構，不須再經封裝製程即可使用，仍未揭露在P 或N 電極上增設大面積導電（導熱）層之技術特徵。是既被證2-3 及被證2-4 均未揭露系爭專利2 請求項1 之大面積導電（導熱）層技術特徵，且被證2-3 及被證2-4 之技術內容亦無相關之建議或教示，所屬技術領域中具有通常知識者由被證2-3及被證2-4 之技術內容，尚難思及在被證2-3或被證2-4 之LED 晶粒P、N 電極上設有大面積導電（導熱）層，故被證2-3及被證2-4 之組合不足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性。

十一、被證2-3 及被證2-5 之組合是否足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性？

(一)比對系爭專利2 請求項1 與被證2-5 之技術內容：查被證2-5第1 圖揭露覆晶型發光二極體晶粒（16）設於底座基板（11），被證2-5 說明書第7 頁第1 至4 行記載「底座基板11 的上方及下方分別有複數個金屬層覆蓋之，其係分別標示為

金屬層12、金屬層13、…。其中，金屬層12及金屬層13分別與透明基板覆晶式發光二極體晶粒的p 極與n 極接觸…」，是以被證2-5 雖對應揭露系爭專利2 請求項1 之發光二極體晶粒具有p 極與n 極，但並未揭露在p 極與n 型上設有大面積導電（導熱）層之技術特徵。

(二)被上訴人雖主張被證2-5 之金屬層（12、13）相當於系爭專利2 請求項1 之大面積導電（導熱）層。惟系爭專利2 請求項1 之請求標的係「晶片」，並具有在P、N 電極處增設大面積導電（導熱）層之技術特徵，可見該大面積導電（導熱）層係晶片本身結構之一，而依前述被證2-5 說明書內容可知，金屬層（12、13）係底座基板（11）之結構，用以供發光二極體晶粒的p 極與n 極進行覆晶接合，是以被證2-5 之金屬層（12、13）並不同於系爭專利2 請求項1 之大面積導電（導熱）層。

(三)被證2-3 及被證2-5 均未揭露系爭專利2 請求項1 之大面積導電（導熱）層技術特徵，且被證2-3 及被證2-5 之技術內容亦無相關之建議或教示，所屬技術領域中具有通常知識者由被證2-3 及被證2-5 之技術內容，尚難思及在被證2-3 或被證2-5 之LED 晶粒P、N 電極上設有大面積導電（導熱）層，故被證2-3 及被證2-5 之組合不足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性

十二、被證2-2、被證2-3、被證2-4 及被證2-5 之組合是否足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性？

被證2-2 及被證2-3 之組合足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性，已如前述，故被證2-2、被證2-3、被證2-4 及被證2-5 之組合自足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性

01

。

02 十三、被證3-2 是否足以證明系爭專利3 請求項1 不具新穎性？

03 (一)比對系爭專利3 請求項1 與被證3-2 之技術內容：查被證3
04 -2圖12揭示一種發光裝置即LED 晶片(1)以覆晶方式連接
05 於安裝基板(8)，該LED 晶片(1)包含N 型半導體層(3)
06 3)、位於N 型半導體層(3)底面之P 型半導體層(5)
07 ；對應揭示系爭專利3 請求項1 之「一種覆晶發光二極體晶
08 粒，包括：一第一型摻雜半導體層；一第二型摻雜半導體層
09 ；鋪設於該第一型摻雜半導體層之底面」技術特徵。被證3
10 -2圖12揭示電極(6)係鋪設於N 型半導體層(3)之底面
11 且不接觸P 型半導體層(5)，並具有一裸露面積以供形成
12 凸塊(21)；電極(7)則鋪設於P 型半導體(5)之底面
13 ；並具有一裸露面積以供形成凸塊(21)；又被證3-2 說明
14 書第25頁第1 至4 行載明「…以焊料、金或其他金屬所形成
15 之凸塊21，而將電極7 連接固定至安裝基板8 之導電體10。
16 亦可使用『導電性黏著劑』加以固定」，教示凸塊(21)可
17 以導電性黏著劑加以取代。前述被證3-2 之技術內容，即對
18 應揭示系爭專利3 請求項1 之「一第一電極層，係鋪設於第
19 一型摻雜半導體層之底面且不接觸該第二型摻雜半導體層，
20 且具有一裸露面積以供直接塗佈一導電接合劑；一第二電極
21 層，係鋪設於第二型摻雜半導體層之底面，且具有一裸露面
22 積以供直接塗佈該導電接合劑」技術特徵。

23 (二)被證3-2 圖12另揭露在電極(6、7)間之絕緣薄膜(20)
24 ；對應揭示系爭專利3 請求項1 之「一絕緣層，位於該第一
25 電極層與該第二電極層間，以電性隔離且支撐該第一電極層
26 與該第二電極層」技術特徵。又被證3-2 圖12中顯示絕緣薄

膜（20）亦包圍部分之LED 晶片（1）周圍，雖可對應於系爭專利3 請求項1 之「防護層」，但不符合防護層「披覆於該覆晶發光二極體晶粒上除了該覆晶發光二極體晶粒頂面、該第一電極層裸露面、該第二電極層裸露面及該絕緣層底面之外所有的表面」技術特徵。故被證3-2 圖12所載之實施例並不足以證明系爭專利3 請求項1 不具新穎性。

(三)原審判決雖認為，被證3- 2說明書第28頁第16至18行所載內容「本實施例中，較佳的情況為，藉由透光性之合成樹脂將LED 晶片1 與其周圍密封，如此一來，可以藉由合成樹脂保護LED 晶片1 」，已揭露系爭專利3 請求項1 之「防護層」技術特徵（原審判決第39頁），惟查，被證3-2 說明書第28頁係在說明第五實施例（圖22至27），與被證3-2 圖12之第二實施例分屬不同態樣，而將不同實施例之技術內容予以組合後始揭露系爭專利3 請求項1 之全部技術特徵，應屬系爭專利3 請求項1 是否具進步性而非新穎性之問題。再者，上訴人於108 年2 月20日提出系爭專利3 之更正申請，更正後請求項1 除包含前述請求項1 之全部技術特徵外，另新增「其中該導電接合劑為銀膠或錫膏；其中當該導電接合劑為銀膠時，每一該裸露面積為至少625 平方微米；其中當該導電接合劑為錫膏時，每一該裸露面積為至少10000 平方微米」技術特徵（原請求項2 、3 之附屬技術特徵），除前述被證3-2 與系爭專利3 請求項1 間之差異外，系爭專利3 請求項1 更正後新增「裸露面積為至少625 或10000 平方微米」之技術特徵，亦未見於被證3-2 ，為被上訴人所不爭執（覆晶公司108 年5 月10日民事答辯（二）狀第28頁，見本院卷二第59頁），是以被證3-2 當不足證明系爭專利3 請求項1 不

具新穎性。

十四、被證3-2 是否足以證明系爭專利3 請求項1 不具進步性？

(一)另查，被證3-2 圖22（第五實施例）及說明書第28頁第3 段載明「LED 晶片1 之各電極係透過導電性膏22（例如銀膏）而分別連接至各導電層12。在此構造中，藉由隨著導電性膏22之硬化所產生的收縮，可以將傳熱元件28與LED 晶片1 緊密黏著…取代導電性膏22，亦可使用和第一實施例相同的凸塊。之後的實施例中也同樣如此」，其中被證3 -2之導電性膏（22）（例如銀膏）即對應揭露系爭專利3 請求項1 之「其中該導電接合劑為銀膠」技術特徵。

(二)系爭專利3 請求項1 與被證3-2 圖12（第二實施例）之差異在於：被證3-2 圖12之絕緣薄膜（20）僅披覆於LED 晶片（1 ）部分側邊，且被證3-2 圖12未揭露導電接合劑為銀膠或錫膏及其裸露面積大小。而被證3-2 圖12雖是以凸塊（21）來連結LED 晶片（1 ）與安裝基板（8 ），然被證3-2 圖22（第五實施例）另揭露可利用導電性膏（22）來置換凸塊，可見不論凸塊或導電性膏均為連結LED 與基板之習用技術手段；此外，被證3-2 說明書第28頁第3 段關於第五實施例之說明，提及「本實施例中，較佳的情況為，藉由透光性之合成樹脂將LED 晶片1 與其周圍密封，如此一來，可以藉由合成樹脂保護LED 晶片1 」，是以所屬技術領域中具有通常知識者基於被證3-2 第五實施例之教示，當可將被證3-2 第二實施例改以導電性膏來連接LED 晶片與基板，且欲進一步提高密封性時，當有合理動機將第二實施例之絕緣薄膜（20）變更為完整覆蓋LED 晶片（1 ）側邊周圍。至於系爭專利3 請求項1 所界定之裸露面積，僅是電極上可供塗佈導電接合

劑的範圍大小，而該裸露面積與不同電極形狀、晶粒尺寸或接合材料之選用等因素相關連，當為所屬技術領域中具有通常知識者依不同LED 晶粒設計需求所為之選擇或簡單改變，況且系爭專利3 說明書中並未提及電極層裸露面積為625 平方微米或10000 平方微米時，具有無法預期之功效，故電極層裸露面積為625 平方微米或10000 平方微米之技術特徵，尚不得作為系爭專利3 相較於被證3-2 具有進步性之依據。綜上，系爭專利3 請求項1 之發明，乃所屬技術領域中具有通常知識者依被證3-2 第五實施例之教示，修飾或改變第二實施例之絕緣薄膜覆蓋範圍並改採導電性膠來接合晶粒與基板所能輕易完成者，故被證3-2 足以證明系爭專利3 請求項1 不具進步性。

(三)上訴人雖辯稱，系爭專利3 之發明目的係在於「未經封裝即可使用」，可免除習知技術於第一階段封裝中將晶粒封裝至轉接板的複雜製程，降低製程時間與設備成本，反觀被證3-2揭露之LED 晶片需安裝於安裝基板或配線基板上，即相當於系爭專利3 所述之習知技術，故所屬技術領域中具有通常知識者由被證3-2 無法輕易完成系爭專利3 請求項1 之發明云云。惟參酌系爭專利3 說明書第8 頁第2 段所載「…本技術態樣三種實施方式之覆晶發光二極體晶粒…其係在晶圓製程階段，於晶粒上設置可直接被使用的大電極結構，進而免除傳統晶粒被封裝成晶片的後段製程」，可知在LED 晶粒上需設有足夠大的電極方能直接連接於印刷電路板上，以免除轉接板之製程；而系爭專利3 請求項1 屬於物（發光二極體晶粒）之發明，應以請求項內容所載之結構為準，據以認定是否具進步性，然其僅於前言部分記載有「未經封裝即可使

用」之目的或後續使用方式，並未記載說明書中達成該目的之技術手段，亦未界定晶粒後續係與何種基板直接接合，自難以之認定系爭專利3 與被證3-2 所揭露之LED 晶粒在結構上有何差異而具有進步性。

(四)上訴人又辯稱，被證3-2 並未揭露系爭專利請求項1 之裸露尺寸面積，且被證3-2 說明書第14頁第2 至7 行記載「…第一電極係隨著從該第一電極上的供電部遠離而小寬度，故能夠增大LED 晶片中之發光部面積」，與系爭專利3 為了免除封裝製程而趨向有大電極結構的目的背道而馳云云。惟就進步性之認定，在確認申請專利之發明與先前技術所揭露之內容間的差異後，仍需進一步判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。換言之，並非只要系爭專利3 請求項1 有部分技術特徵（裸露面積大小）未見被證3-2 ，即能逕認系爭專利3 請求項1 具有進步性，仍需視該差異之技術特徵是否為所屬技術技術領域中具有通常知識者在解決特定問題時，能利用申請時之通常知識進行簡單選擇而加以完成者，或是否能據此產生無法預期之功效。而如前述，LED 晶粒之電極裸露面積大小，係所屬技術領域中具有通常知識者依不同設計需求或配合不同的電極形狀、尺寸、接合材料等因素得為最適之調整或變化者，且系爭專利3 並未因該特定的電極裸露面積大小產生無法預期之功效，自難認具有進步性。又前述被證3-2 說明書第14頁第2 至7 行之內容，參照被證3-2 圖2 及說明書第19頁第1 段內容，可知被證3-2 係將電極（6 、7 ）設為相對且交錯之梳狀，並具有隨著供電部遠離而寬度縮小之特徵，如此可增加發光

01 效率。然被證3-2 之電極（6、7）用來與凸塊連接處係「
02 供電部（15、16）」（相當於系爭專利3 所指之電極「裸露
03 面積」），並非寬度縮小之處，況且系爭專利3 請求項1 並
04 無所謂「大電極」結構之技術特徵，是上訴人上開辯解，並
05 不足採。

06 十五、綜上所述，被證1-2，及被證1-3，及被證1-2 及被證1
07 -3之組合，足以證明系爭專利1 請求項3、5、6、8 不
08 具進步性。被證2-2 及被證2-3 之組合，及被證2-2、被
09 證2-3、被證2-4 及被證2-5 之組合，足以證明系爭專利
10 2 請求項1 不具進步性。被證3-2 足以證明系爭專利3 請
11 求項1 不具進步性。系爭專利1、2 違反92年專利法第22
12 條第4 項，系爭專利3 違反103 年專利法第22條第2 項規
13 定，具有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條
14 第2 項之規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。從而，
15 上訴人依專利法第96條第1、2、3 項、第97條，民法第
16 185 條第1 項前段及公司法第23條第2 項之規定，請求被
17 上訴人等排除侵害及連帶負損害賠償責任，均無理由。原
18 審判決為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，並
19 無不當，上訴意旨聲明不服，求予廢棄改判，為無理由，
20 應予駁回。

21 十六、本件事證已臻明確，兩造間其餘專利有效性之爭點及系爭
22 產品1、2 是否落入系爭專利1、2、3 之專利權範圍及
23 損害賠償計算等攻擊防禦方法及援引之證據，經本院斟酌
24 後，認均不影響本判決之結果，爰不予審究，附此敘明。

25 十七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第
26 1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文

01 中 華 民 國 108 年 8 月 29 日

02 智慧財產法院第二庭

03 審判長法 官 汪漢卿

04 法 官 曾啟謀

05 法 官 彭洪英

06 以上正本證明與原本無異。

07 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
08 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
09 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
10 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
11 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1
12 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律
13 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

14 中 華 民 國 108 年 8 月 29 日

15 書記官 郭宇修

16 附註：

17 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

18 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
19 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

20 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
21 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
22 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。